



УЧРЕЖДЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РАН
ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ

Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Золотодолинская, 11, к. 225-227.
тел. (383) 330-42-43, e-mail media@sbras.nsc.ru

ПРЕСС-РЕЛИЗ

РОСТЕХНОЛОГИИ ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ РАЗРАБОТКАМИ СО РАН

В Институте физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН состоялась встреча представителей сибирского отделения РАН и холдинга НИК «Оптические системы и технологии» (входит в состав госкорпорации «Ростехнологии»).

Начал встречу заместитель директора ИФП СО РАН, член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, профессор Анатолий Васильевич Двуреченский. Он кратко охарактеризовал институт и ведущие направления его деятельности:

- Помимо того, что мы как исследовательский институт занимаемся получением нового знания, мы также разрабатываем высокотехнологичные продукты в качестве опытных образцов, которые потом можно будет пустить в производство. Направления работы института это - физика полупроводников и диэлектриков, элементная база микро- и нанoeлектроники, разработка фотоприемников и фотоприемных устройств, лазерная оптика.

Гостям были представлены ведущие разработки института. Работа фотоприемных устройств демонстрировалась в реальном времени: можно было поднести руку и увидеть, как она отображается на экране монитора, проверить чувствительность и точность работы аппарата, реакцию на движение и другие характеристики.

Также была представлена установка молекулярно-лучевой эпитаксии, позволяющая создавать гетероэпитаксиальные структуры «кадмий-ртуть-теллур». Их можно вырастить чувствительными к любой длине волны, и на основе этого базового материала создавать фотоприемники с высокой эффективностью. В частности, подобная технология используется для создания тепловизоров. Как пояснил старший научный сотрудник ИФП СО РАН кандидат физико-математических наук Максим Витальевич Якушев:

- Данная установка многокамерная: каждый процесс проходит в отдельном отсеке. Это позволило наладить поточное производство. Кроме того, каждая камера имеет свою остаточную атмосферу, что позволяет получать низкую плотность дефектов в полученных слоях материала.

Подготовила:
Юлия Позднякова
15.11.2011

Контакты:
(383) 330 42 43
+7 903 938 01 53
pozd@sbras.nsc.ru



На фото: Установка молекулярно-лучевой эпитаксии и Максим Якушев



На фото: Представитель "Оптических систем и технологий" тестирует фотоприемник